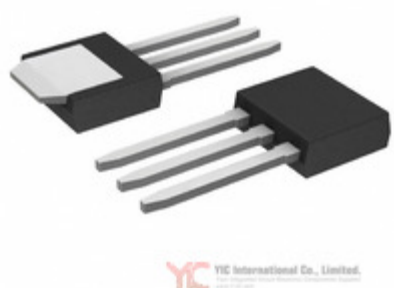

	<p><b>GP2M002A065PG</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> GP2M002A065PG</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Global Power Technologies Group</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 1.8A IPAK</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">GP2M002A065PG.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>




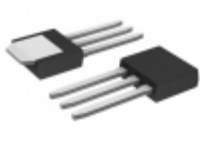



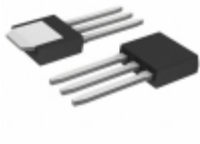
Spezifikationen

Teilenummer	GP2M002A065PG
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 1.8A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.6 Ohm @ 900mA, 10V
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	353pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.8A (Tc)

GP2M002A065PG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP2M002A065PG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP2M002A065PG Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP2M002A065PG E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>GP2M004A060CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 4A DPAK</p>	 <p><b>GP2M004A060HG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 4A TO220</p>	 <p><b>GP2M002A060HG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 2A TO220</p>	 <p><b>GP2M004A060PG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 4A IPAK</p>
 <p><b>GP2M002A065CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 1.8A DPAK</p>	 <p><b>GP2M002A065HG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 1.8A TO220</p>	 <p><b>GP2M004A065CG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 4A DPAK</p>	 <p><b>GP2M002A060PG</b> Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 2A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP2M002A065PG Global Power Technologies Group	GP2M002A065PG Datenblatt	GP2M002A065PG-Datenblätter	GP2M002A065PG PDF	Global Power Technologies Group GP2M002A065PG
GP2M002A065PG Electronic	GP2M002A065PG-Komponenten	GP2M002A065PG-Verteiler	GP2M002A065PG-Bild	GP2M002A065PG-Teil
GP2M002A065PG Preis	GP2M002A065PG Hersteller	GP2M002A065PG Bild	GP2M002A065PG Aktie	GP2M002A065PG Inventar
GP2M002A065PG Neu	GP2M002A065PG Original	GP2M002A065PG garantiert	GP2M002A065PG RFQ	GP2M002A065PG Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited